

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 61-216381

(43)Date of publication of application : 26.09.1986

(51)Int.CI.

H01S 3/18

(21)Application number : 60-056943

(71)Applicant : FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing : 20.03.1985

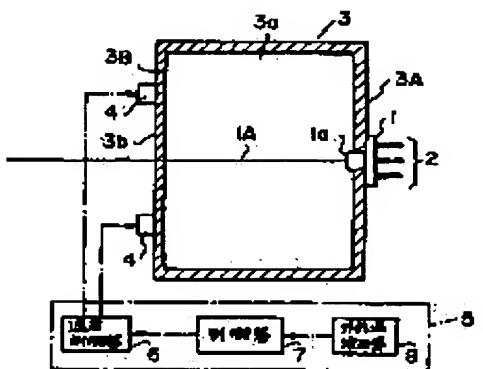
(72)Inventor : HORIKAWA KAZUO

## (54) SEMICONDUCTOR LASER SOURCE

### (57)Abstract:

**PURPOSE:** To avoid dewing on the emitting end surface of a semiconductor laser and on a laser beam passage by a method wherein the semiconductor laser is provided in a case which protects the laser emitting end surface from exposure to the open air and a heater, which heats the parts of the case surface where the laser beam transmitts, is provided.

**CONSTITUTION:** A semiconductor laser 1 is provided in a case 3 which protects the laser beam 1A emitting end surface from exposure to the open air and a heater 4, which heats the part of the case 3 where the laser beam 1A transmitts, is provided. Even if the temperature of the semiconductor laser drops below the open air temperature, dewing is avoided because the emitting end surface is protected from exposure to the open air. Even if the temperature of the air in the case 3 and the temperature of the case 3 itself drop by following the temperature drop of the semiconductor laser 1, dewing is also avoided because the part of the case 3 where the laser beam 1A transmitts is heated by the heater 4. Therefore, deterioration of convergency, directivity and the like of the laser beam caused by dewing on the laser beam passage is avoided.



⑯日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫公開特許公報(A) 昭61-216381

⑬Int.Cl.  
H 01 S 3/18

識別記号 庁内整理番号  
7377-5F

⑭公開 昭和61年(1986)9月26日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

⑮発明の名称 半導体レーザ光源装置

⑯特 願 昭60-56943

⑰出 願 昭60(1985)3月20日

⑱発明者 堀川 一夫 神奈川県足柄上郡開成町宮台798番地 富士写真フィルム  
株式会社内

⑲出願人 富士写真フィルム株式  
会社 南足柄市中沼210番地

⑳代理 人 弁理士 柳田 征史 外1名

明細書

1. 発明の名称

半導体レーザ光源装置

2. 特許請求の範囲

レーザビームを発する半導体レーザを備えた半導体レーザ光源装置において、前記半導体レーザが、少なくともレーザビーム射出端面を外気から遮断させるケース内部に設けられ、該ケースの表面の、少なくとも前記レーザビームが透過する部分を加熱するヒータを備えたことを特徴とする半導体レーザ光源装置。

3. 発明の詳細な説明

(発明の分野)

本発明は半導体レーザを備えた半導体レーザ光源装置に関するものであり、特に詳細には半導体レーザおよび半導体レーザから発せられるレーザビームの光路上に結露が生じることを防止する手段を備えた半導体レーザ光源装置に関するものである。

(発明の技術的背景および先行技術)

従来より、光ビームを光偏向器により偏向して走査する光ビーム走査装置が、例えば各種走査記録装置、走査読み取り装置等において広く実用に供されている。このような光ビーム走査装置において光ビームを発生する手段の一つとして、半導体レーザが従来から用いられている。この半導体レーザは、ガスレーザ等に比べれば小型、安価で消費電力も少なく、また駆動電流を変えることによって直接変調が可能である等、数々の長所を有している。

これらの半導体レーザは、寿命、効率、発光強

特開昭61-216381 (2)

を提供することを目的とするものである。

(発明の構成)

本発明の半導体レーザ光源装置は、半導体レーザが、少なくともレーザビーム射出端面を外気から遮断させるケース内部に設けられ、該ケースの表面の、少なくとも前記レーザビームが透過する部分を加熱するヒータを備えたことを特徴とするものである。前記ケースは、レーザビームの射出端面を外気から遮断することにより射出端面上に結露が生じることを防止するものであり、前記ヒータは、レーザビームの光路であるケース上の位置に結露が生じることを防止するものである。すなわち、半導体レーザの温度が外気に比べて低くなってしまっても、前記射出端面は外気から遮断されていることにより、結露の発生が防止されるとともに、半導体レーザの温度低下に伴なってケース内の空気およびケース自体の温度が低下しても、ケースの、レーザビームが透過する部分はヒータにより加熱されているので結露の発生が防止される。従ってレーザビームの光路上に結露が生じ、レーザ

度等の点からみて、できるだけ低い温度で作動させることができることが望ましい。このため、半導体レーザを支持するマウント等に冷却素子を取り付け、半導体レーザを冷却しながら作動させるといった工夫もなされている。しかしながら、半導体レーザを冷却した結果、外気の温度に比べて半導体レーザの温度が低くなると、半導体レーザの表面上に結露が生じてしまうことがある。半導体レーザに結露が生じると、結露の位置がレーザビームの射出端面上である場合には、結露がレンズの作用をして、レーザビームの集束性や方向性に悪影響を与える他、電気的にも絶縁不良を招くなど、半導体レーザの良好な作動を妨げる種々の障害が生じさせる原因となるという問題がある。

(発明の目的)

本発明は上記のような問題点に鑑みてなされたものであり、半導体レーザ作動時に、半導体レーザの温度を外気に比べて低温になるように制御しても、半導体レーザおよびレーザビームの光路上に結露が生じることのない半導体レーザ光源装置

ビームの集束性、方向性等が損なわれるという不都合が生じなくなる。

(実施態様)

以下、図面を参照して本発明の実施態様について説明する。

第1図は本発明の一実施態様による半導体レーザ光源装置の概要を示す斜視図であり第2図はその縦断面図である。

半導体レーザ1は、リード線2から電力を供給されることにより作動可能となっており、ガラス等の、レーザビームの透過を許す材料からなるケース3の一側壁3Aに取り付けられ、レーザビーム射出端面1aをケース内方に露出させている。またこのケース3は、その内部を外気から遮断せしめるようになっている。半導体レーザ1はレーザ近傍に取り付けられた温度制御素子(図示せず)により作動に好適な、比較的低い温度に温度制御され、前記射出端面1aからレーザビーム1Aを発する。発せられたレーザビーム1Aはケース3内を経て前記ケースの一側壁3Aと対向する他側壁

3Bを通過し、ケース3外方に射出される。

半導体レーザ1が温度制御されることにより、外気より低温になると、半導体レーザ1とともに前記ケース3内の空気3aおよびケース3が冷却される。しかしながら、半導体レーザの射出端面1aは外気から遮断されているので、この射出端面上に結露が生じることはない。

ところでケース内の空気3aおよびケース3が上記のように冷却されると、その内部と外部の温度差により、ケース3は、表面に結露が生じやすい状態となる。この結露がケース3の、レーザビームの透過する部分に生じると、結露がレンズ作用をして種々の不都合が生じる。そこで、本実施態様の装置においては、前記他側壁3Bの外壁面3b上に、一対のヒータ4、4が設けられている。このヒータ4、4は前記外壁面3b上に、前記レーザビーム1Aが透過する部分の近傍に設けられ、ケース3の、レーザビームが透過する部分を加熱するものである。このヒータ4、4が作動することにより、半導体レーザ1の作動に伴なって冷却さ

れ、外気温より低温となる他隔壁3日の、レーザビームが透過する部分は加熱され、結露の発生が防止される。従って、レーザビーム1Aは結露による悪影響を受けることなく、その集束性、方向性等を高精度に維持することができる。なお、ヒータによる加熱は、他隔壁3日の、少なくともレーザビームが透過する部分が、結露を生じることのない温度となるように行なわれればよいが、結露の防止を確実に行なうためには、レーザビームが透過する部分が外気温よりやや高温となるように加熱するのが望ましい。また装置を使用する環境がほぼ一定であって、外気温の変動が小さい場合には、ヒータは常に一定の条件で作動せしめられ、ケース表面の、レーザビームが透過する部分が一定の温度を保つように加熱を行なうようにすればよいが、使用環境の変動等による外気温の変化が予想される場合や、温度制御を高精度に行なう必要のある場合には、第2図に一点鎖線で示すようなヒータ制御回路5を設け、このヒータ制御回路5により、ヒータの駆動を制御することも可能である。

く、例えば前記外壁面3b上に、レーザビームが透過する部分をとり囲む円環状のヒータを設けること等も可能である。またヒータを設ける位置も前記外壁面3b上に限らず他隔壁3日の内壁面上であってもよいし、ヒータを壁面上に固定せず、ケース近傍にヒータを設け、ケース外方からケース表面のレーザビーム透過部分を加熱させるようにしてもよい。また、上記実施態様においては、半導体レーザはそれぞれ1つずつ設けられているが、同一のケース内部に複数の半導体レーザが設けられていてもよく、その場合には各々の半導体レーザから発せられるレーザビームが透過するケースの表面部分をヒータにより加熱すればよい。また半導体レーザは少なくともレーザビーム射出端面が外気から遮断されなければよく、半導体レーザ全體がケースの内方に位置するように配されていてもよい。

#### (発明の効果)

以上説明したように本発明の半導体レーザ光源装置によれば、半導体レーザが、少なくともレーザビームが透過する部分を加熱するヒータを備えたことにより、半導体レーザが外気に比べて低温に制御された際にも、半導体レーザの射出端面およびレーザビームの光路上に結露が生じることが防止される。従って、本発明によれば、電気的に絶縁不良が生じる等の不都合が生じることなく、方向性、集束性等の精度にすぐれたレーザビームを発する半導体レーザ光源装置を得ることができる。

能である。

ヒータ制御回路5には、温度制御器6、この温度制御器6を制御する制御器7および外気温を検出し、検出信号を制御器7に送る外気温検出器8が設けられている。すなわち、外気温検出器8により、外気温が検出され、検出信号が制御器7に送られると、制御器7は送られた検出信号に基づいて、温度制御器6に制御信号を発する。温度制御器6はこの制御信号に基づいてヒータ4、4を適切な強度で駆動せしめる。従ってヒータ4、4は外気温の変動に伴なって、その加熱強度を変化せしめられ、常に外気温に対応して最も適切な強度の加熱を行なうことが可能となる。またヒータ4を、ケース3を高温に加熱させることも可能なものとし、前記外壁面上の、レーザビームを透過させる部分の近傍に温度検出器を設け、この温度検出器からの信号に基づいてヒータの駆動をON-OFFさせるようにしてもよい。

なお、ヒータの数、大きさ、形状等は上記の実施態様において示したものに限られるものではな

ザビーム射出端面を外気から遮断するケース内部に設けられ、さらにケースの表面の、レーザビームが透過する部分を加熱するヒータを備えたことにより、半導体レーザが外気に比べて低温に制御された際にも、半導体レーザの射出端面およびレーザビームの光路上に結露が生じることが防止される。従って、本発明によれば、電気的に絶縁不良が生じる等の不都合が生じることなく、方向性、集束性等の精度にすぐれたレーザビームを発する半導体レーザ光源装置を得ることができる。

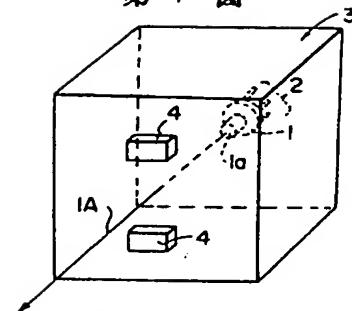
#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施態様による半導体レーザ光源装置の概要を示す斜視図。

第2図は上記半導体レーザ光源装置の断面図である。

1 … 半導体レーザ	1 A … レーザビーム
3 … ケース	4 … ヒータ

第 1 図



第 2 図

